

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁶
H01L 21/265

(11) 공개번호 특1997-0077172
(43) 공개일자 1997년 12월 12일

(21) 출원번호	특1996-0014211
(22) 출원일자	1996년 05월 02일
(71) 출원인	현대전자산업 주식회사 김주용
(72) 발명자	경기도 이천군 부발읍 아미리 산 136-1 (우 : 467-860) 유진산 서울특별시 구로구 시흥 1동 789 한양아파트 1동 106호 진병주 경기도 성남시 중원구 은행 1동 현대아파트 101동 1508호
(74) 대리인	최승만, 신영무

심사청구 : 없음

(54) 반도체 소자 제조 방법

요약

본 발명은 이온 주입 공정시 포토 리소그래피 공정을 거치지 않고 마스크를 이용하여 이온 주입 영역을 형성함으로써, 공정 시간을 단축시킬수 있고, 불순물 이온 주입 기술을 향상시킬 수 있는 반도체 소자 제조 방법이 개시된다.

대표도

도2c

명세서

[발명의 명칭]

반도체 소자 제조 방법

[도면의 간단한 설명]

제2A도 내지 제2C도는 본 발명에 따른 반도체 소자 제조 방법을 설명하기 위한 단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

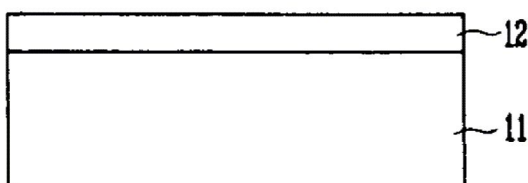
청구항 1

반도체 소자 제조 방법에 있어서, 실리콘 기판상에 산화막을 형성하는 단계와, 상기 전체 구조 상부에 이온 주입 마스크를 이용하여 불순물 이온 주입 장비로 이온을 주입하여 이온 주입 영역을 형성하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 소자 제조 방법.

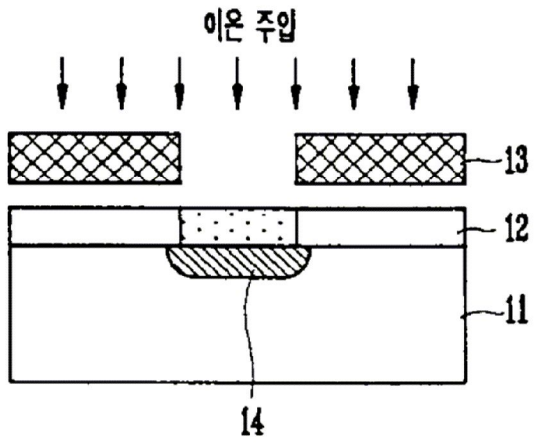
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면2a



도면2b



도면2c

